



■ パワートランジスタモジュール Power Transistor Modules

スナバ用ツェナーダイオード内蔵パワートランジスタモジュール
Power transistor modules with zener diode for snubber circuit

形式 Device type	V _{CEO}	V _{CEO} (sus)	I _C	P _C	hFE (T _J =125°C)			スイッチングタイム			パッケージ Package Page 63	質量 Net mass Grams
	Volts	Volts	Cont. Amps.	Watts	(Min.)	I _C Amps.	V _{CE} Volts	t _{on} μsec.	t _{sig} μsec.	t _f μsec.		
1DI300MN-050	600	450	300	1380	3000	300	2.5	5.5	8.0	2.0	M115	430
1DI400MN-050	600	450	400	1500	2000	400	2.5	8.5	8.0	2.0	M115	430
1DI400MP-050	600	450	400	1500	2000	400	2.5	8.5	8.0	2.0	M114	430
1DI300MN-120	1200	900	300	2000	1500	300	4.0	7.0	15.0	3.0	M118	430
1DI300MP-120	1200	900	300	2000	1500	300	4.0	7.0	15.0	3.0	M117	430
1DI400MN-120	1200	900	400	3000	2000	400	4.0	3.0	15.0	3.0	M118	430
1DI400MP-120	1200	900	400	3000	2000	400	4.0	3.0	15.0	3.0	M117	430
1DI200ZN-120	1200	1200 *	200	1400	100	200	5.0	3.0	15.0	2.0	M115	430
1DI200ZP-120	1200	1200 *	200	1400	100	200	5.0	3.0	15.0	2.0	M114	430
1DI300ZN-120	1200	1200 *	300	2000	100	300	5.0	3.0	15.0	2.0	M115	430
1DI300ZP-120	1200	1200 *	300	2000	100	300	5.0	3.0	15.0	2.0	M114	430

* V_{CEX(sus)}

シングルインラインパッケージ6個組パワートランジスタモジュール
Single in-line package / 6 in one-package power transistor modules

形式 Device type	V _{CEO}	V _{CEO} (sus)	I _C	P _C	hFE (T _J =125°C) *			スイッチングタイム			パッケージ Package Page 70	質量 Net mass Grams
	Volts	Volts	Cont. Amps.	Watts	(Min.)	I _C Amps.	V _{CE} Volts	t _{on} μsec.	t _{sig} μsec.	t _f μsec.		
6DI10MS-050	600	450	10	50	100	10	2.0	2.0	8.0	2.0	M615	65
6DI15S-050	600	450	15	60	100	15	5.0	1.0	12.0	2.0	M614	40
6DI15MS-050	600	450	15	60	150	15	2.5	2.0	8.0	2.0	M615	65
6DI20MS-050	600	450	20	80	200	20	2.5	2.0	8.0	2.0	M615	65

* 6DI15S-050: T_J= 25°C